

2SD362

NPN エピタキシャルメサ形シリコントランジスタ

NPN SILICON EPITAXIAL MESA TRANSISTOR

低速度大電流スイッチング, 低周波電力増幅用

Low Speed High Current Switching, Low Frequency Power Amplifier

通信工業用/Industrial Use

特 徴/FEATURES

・小型外形に比し, 大きな電流が流せ, かつ安全動作領域が広い。
High current.

$I_{C(DC)}=5.0A$, $I_{C(Pulse)}=8.0A$

・ラインプリンタのハンマドライバ, パルスモータドライバ, リレードライバ,
DC-DC コンバータ等誘導性負荷のスイッチング用途に適する。

Suitable for use in inductive load applications such as hammer driver
of line printer, pulse motor driver, relay driver, DC-DC converter, etc.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	8.0	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	5.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(Pulse)}^*$	8.0	A
全損失	$P_T(T_c=25^\circ C)$	40	W
ジャンクション温度	T_j	175	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100V$, $I_E=0$			20	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$, $I_C=0$			100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5.0V$, $I_C=5.0A^*$	30	45	120	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5.0A$, $I_B=0.5A^*$		0.6	1.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=5.0A$, $I_B=0.5A^*$		1.2	1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V$, $I_E=-100mA$		10		MHz

* パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)